

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
印章/Marking: Y1
特点/Features:
 I_C 电流大;

用途/Applications:

用于功率放大电路, 与 SS8550 互补。

极限参数/Absolute maximum ratings (Ta=25°C)


参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CB0}	40	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	25	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EB0}	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	1.5	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.3	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C=100\mu A, I_E=0$	40			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C=100\mu A, I_B=0$	25			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E=100\mu A, I_C=0$	5			V
集电极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=40V, I_E=0$			0.1	μA
发射极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=5V, I_C=0$			0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I_{CE0}	$V_{CE}=20V, I_B=0$			0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1V, I_C=100mA$	120		400	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1V, I_C=800mA$	40			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=800mA, I_B=80mA$			0.5	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=800mA, I_B=80mA$			1.2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=50mA, f=30MHz$	100			MHz

 h_{FE} 分档/Classification of h_{FE} (1)

档位/Rank	L	H	J
范围/Range	120~200	200~350	300~400

典型特性曲线图/Typical Characteristics
